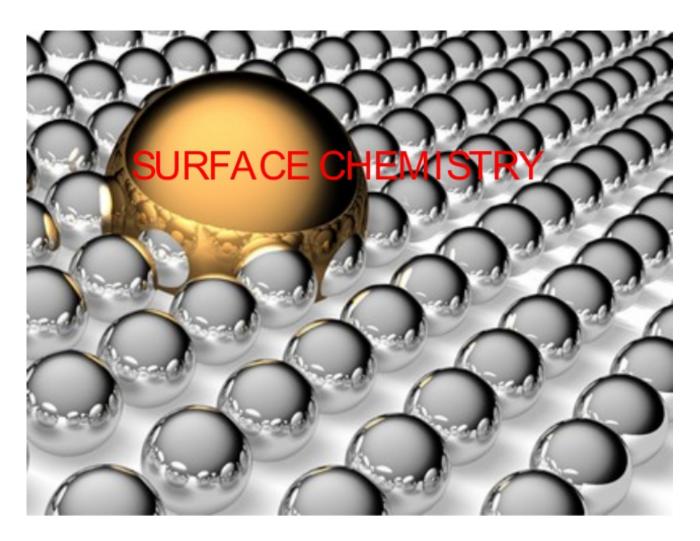
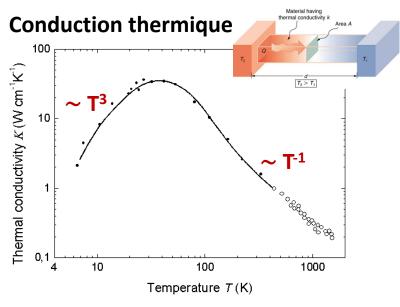
Cours de Chimie Générale Avancée

Mardi, 8:15 – 10:00 et 11:15 – 12:00

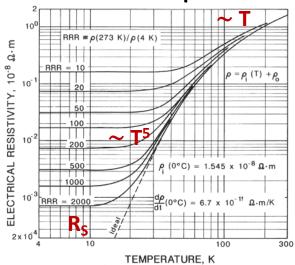
Prof. Dr. Andreas ZÜTTEL



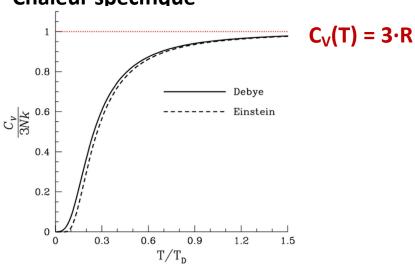
RAPPEL Propriété des Métaux



Résistance électrique



Chaleur spécifique





Proprieté chimique









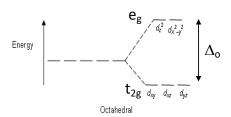


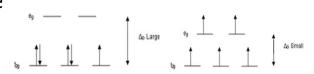


RAPPEL Complexe des éléments de transition

- 1. Écrire la **configuration électronique** des cations des métaux de transition
- 2. Connaître le **diagramme de séparation des énergies** induite par un arrangement octaédrique des ligands. Connaître la nomenclature des **orbitales t**_{2g}, **e**_g.
- 3. En utilisant la théorie du champ cristallin octaédrique, écrire la configuration électronique de ces cations dans un complexe à champ fort (spin faible) et champ faible (spin fort)
- 4. Reconnaître un complexe diamagnétique et paramagnétique. Calculer le spin total. Calculer le moment magnétique (en multiple de μ_B)
- 5 Calculer la longueur d'onde (et la fréquence) de la lumière absorbée par ces complexes à partir de **l'énergie du champ** cristallin Δ_0 (et vice versa)
- 6. Estimer la couleur d'un complexe à partir d'une valeur de Δ_0 en utilisant le diagramme des **couleurs complémentaires**.

Fe²⁺ est 1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁶





$$\mu = \mu_B \sqrt{n(n+2)}$$

n: nombre d'électrons célibataires μ_{R} = 5.79 10⁻⁵ eV/T

$$\lambda = h \cdot c/\Delta_0$$

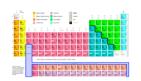
 $h = 6.62608 \times 10^{-34} \text{ J s}$ $c = 2.997925 \times 10^8 \text{ m/s}$



Programme du cours

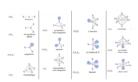
1. Structure de la matière (1 + 2)

modèle atomique, interaction photons/matière, classification périodique des éléments.



2. Liaisons chimiques et réactivité (3 + 4)

différents types de liaison, hybridation, géométries de molécules, Quantités chimiques. réaction équilibrée, réaction complète, stœchiométrie.



3. Thermodynamique (5 + 6)

énergie chimique, enthalpie, entropie, trois principes de la thermodynamique. Thermodynamique des mélanges, Équilibres chimiques





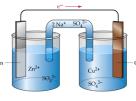
4. Acides et bases (7 + 8)

modèle de Bronsted, pK_a et pK_b, Lewis acide, solutions tampon, titrage.

| March | Marc

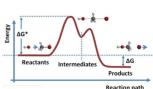
5. Electrochimie (9)

Pile thermodynamique, potentiel standard, Loi de Faraday, Loi de Nernst



6. Cinétique chimique (10)

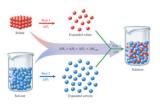
vitesse de réaction, ordre de réaction, énergie d'activation, réactions élémentaires, catalyse.



Programme du cours

7. Propriétés des solutions (11)

Enthalpie de dissolution, Produit de solubilité, Loi de Henry (solution d'un gaz dans l'eau), Propriétés colligatives des solutions



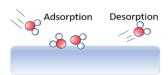
8. Propriétés des métaux (12)

Liaison et structure des bandes, structure cristalline, Phonon, propriétés thermique, propriétés électrique, propriétés chimique, alliages. Complexes des métaux de transition



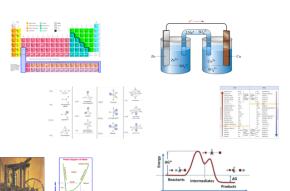
9. Chimie de la surface (13)

Structure de la surface, énergie de la surface, physisorption, chimiesorption, Thermo désorption, Spectroscopie

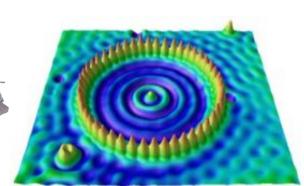


10. Résumé (14)









SOMMAIRE Chimie de la surface

9.1. Surface et Interface

- 9.1.1. "Dispersion", l'autre relation A/V
- 9.1.2. Nombre d'atome à la surface
- 9.1.4. La surface spécifique d'un particule (A/m)
- 9.1.5. Représentation schématique d'une surface
- 9.1.6. Qu'est-ce qu'une interface?
- 9.1.7. Différents scénarios de surface et d'interface
- 9.1.8. Frittage

9.2. La structure d'une surface

- 9.2.1. Structure model de la surface
- 9.2.2. Les trois structures de base sont fcc, hcp et bcc
- 9.2.3. Faces en cristal et Indices Miller
- 9.2. 4. Réseau 2D simple
- 9.2.5. Surfaces de cristal idéales
- 9.2.6. Surfaces cristallines Reconstruction et super-réseaux
- 9.2.7. Défauts de surface et structures
- 9.2.8. Sites de surface et les adsorbant
- 9.2.9. Notation de Wood et Notation de matrice

SOMMAIRE Chimie de la surface

9.3. Propriétés des surfaces

- 9.3.1. Caractéristiques électroniques et vibratoires des surfaces
- 9.3.2. Énergie de surface
- 9.3.3. Tension surface
- 9.3.4. Mesure de la tension de surface

9.4. Physisorption

- 9.4.1. Adsorption à la surface
- 9.4.2. Physisorption et chimisorption
- 9.4.5. Lennard-Jones potentiel
- 9.4.6. Isotherme d'adsorption de Langmuir
- 9.4.7. BET et autres isothermes d'adsorption
- 9.4.7. BET et autres isothermes d'adsorption
- 9.4.8. Model d'adsorption BET
- 9.4.9. Type de l'isotherme d'adsorption BET
- 9.4.10. Description de l'isotherme d'adsorption BET
- 9.4.11. Mesurer la surface spécifique au moyen de BET

SOMMAIRE Chimie de la surface

9.5. Chimisorption

- 9.5.1. Désorption thermique
- 9.5.2. Chaleur d'adsorption par rapport à la couverture
- 9.5.3. Spectroscopie de désorption thermique
- 9.5.4. Déterminer l'energie d'activation
- 9.5.5. Détermination du temps de résidence
- 9.5.6. Surfaces équipotentielles pour l'énergie d'interaction H₂ et Cu
- 9.5.7. Échange isotopique H, D
- 9.5.8. Calcul DFT de l'énergie de H
- 9.5.9. Energie d'un atome de H dans un métal (calcule DFT)

Ref.: http://www.chem.qmul.ac.uk/surfaces/scc/

9.1. Surface et Interface

Common Sense: Une surface est la coque d'un objet macroscopique (l'intérieur) en contact avec son environnement (le monde extérieur). Une interface est la limite entre deux phases.

La surface d'un objet détermine son apparence optique, son caractère collant, son comportement au mouillage, son comportement au frottement et sa réactivité chimique, par ex.

- dans les gros objets de faible surface (A/V), les propriétés physiques et chimiques sont principalement définies par la masse (à l'intérieur)
- dans les petits objets avec un grand rapport A/V, les propriétés sont fortement influencées par la surface

Dans un solide, la densité des atomes est de l'ordre de 10²³ atome·cm⁻³, donc seulement un petit nombre d'atomes de surface par rapport au nombre d'atomes en vrac.

$$\frac{A}{V} = \frac{c_A}{c_V} \frac{1}{d}$$

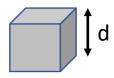
sphere: $V = \frac{1}{6} \pi \cdot d^3$

 $A = \pi \cdot d^2$



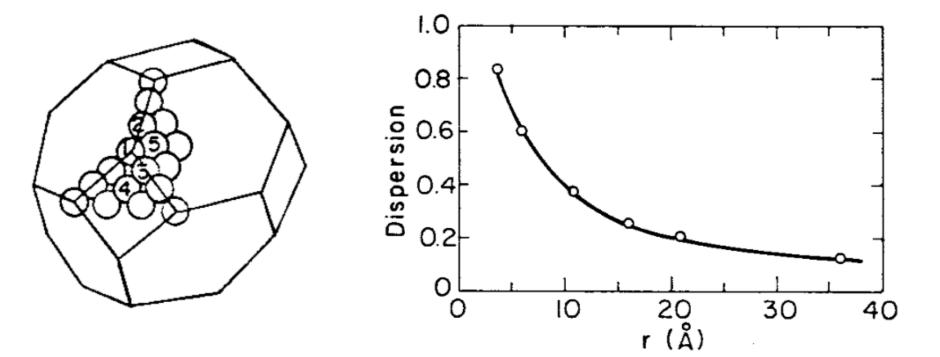
ube: $V = d^3$

 $A = 6 \cdot d^2$



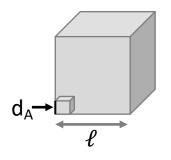
9.1.1. "Dispersion", l'autre relation A/V

"dispersion": rapport entre le nombre d'atomes de surface et le nombre total d'atomes dans une particule.



exemple: variation de la dispersion en fonction de la taille des particules pour un compactage compact (fcc) de particules sphériques.

9.1.2. Nombre d'atome à la surface



$$N = n \cdot N_A = \frac{m}{M} \cdot N_A = \frac{\rho \cdot V}{M} \cdot N_A = \frac{\rho \cdot \ell^3}{M} \cdot N_A$$

$$V_A = d_A^3$$

Volme d'un atome

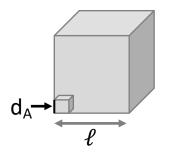
$$\frac{N_S}{N_V} = \frac{\frac{6 \cdot \ell^2}{d_A^2}}{\frac{\ell^3}{d_A^3}} = \frac{6 \cdot d_A}{\ell}$$
 Fraction de nombre d'atome a la surface

attention:

$$d_A/\ell = 0.1 \rightarrow N_S/N = 0.6 \text{ mais } 488/1000 = 0.488$$

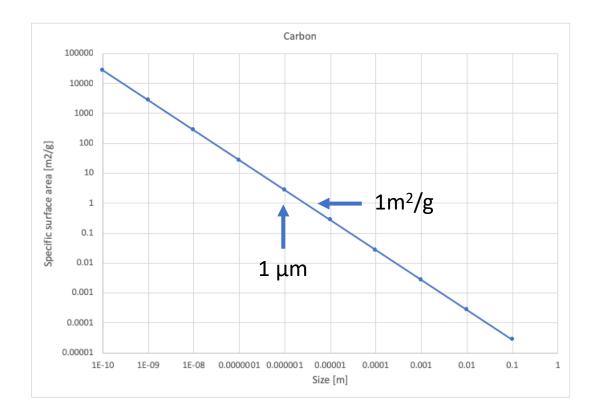
 $d_A/\ell = 0.2 \rightarrow N_S/N = 1.2 \text{ mais } 98/125 = 0.784$

9.1.3. La surface spécifique d'un particule (A/m)

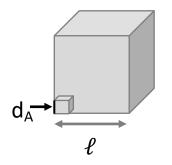


Surface specific:
$$S = \frac{surface}{poids}$$

$$S = \frac{6 \cdot \ell^2}{\rho \cdot \ell^3} = \frac{6}{\rho \cdot \ell}$$



Exercice: Nombre d'atome a la surface: calcule exacte $N_s = N_{tot} - N_v$



$$N_{V} = \frac{(\ell - 2d_{A})^{3}}{d_{A}^{3}} = \frac{1}{d_{A}^{3}} \cdot \{\ell^{3} - 6 \cdot \ell^{2} \cdot d_{A} + 12 \cdot \ell \cdot d_{A}^{2} - 8 \cdot d_{A}^{3}\}$$

$$N_V = \frac{\ell^3}{d_A^3} - 6 \cdot \frac{\ell^2}{d_A^2} + 12 \cdot \frac{\ell}{d_A} - 8$$
 avec $N = \frac{\ell^3}{d_A^3}$

$$N_s = N - N_V = 6 \cdot \frac{\ell^2}{d_A^2} + 12 \cdot \frac{\ell}{d_A} - 8$$

$$\frac{N_s}{N} = 6 \cdot \frac{d_A}{\ell} - 12 \cdot \frac{d_A^2}{\ell^2} + 8 \frac{d_A^3}{\ell^3}$$
 calcule exact avec correction pour les

calcule exact avec bord et les coins.

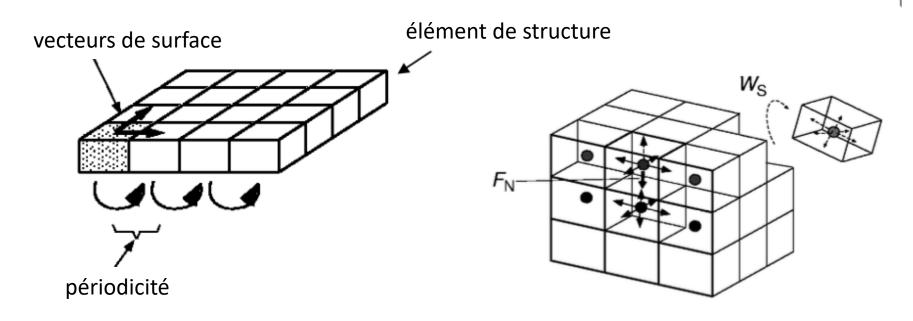
avec la correction:

$$d_A/\ell = 0.1 \rightarrow N_S/N = 0.488 \text{ et } 488/1000 = 0.488$$

 $d_A/\ell = 0.2 \rightarrow N_S/N = 0.784 \text{ et } 98/125 = 0.784$

9.1.5. Représentation schématique d'une surface

Symétrie de translation des éléments de structure dans une surface ordonnée: réseau cristallin idéalisé



En trois dimensions, la structure s'étend sur un côté de la surface dans la masse.

 F_N est la force normale agissant sur un élément de surface vers l'ensemble, à cause des éléments manquants à l'extérieur.

W_s est le travail de transfert d'un élément de surface en phase gazeuse.

9.1.6. Qu'est-ce qu'une interface?

Une interface est la couche de séparation entre deux phases condensées (généralement les dimensions moléculaires).

adhésion: interactions attractives entre deux milieux différents

cohésion: interactions attractives au sein d'une phase (solide ou liquide)

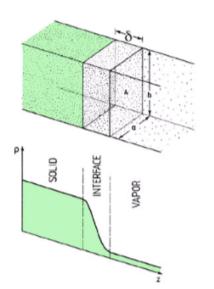
*

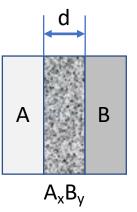
environnante moyenne (liquide ou solide)

région interfaciale

substrat (solide ou liquide)

Aux limites d'un solide ou d'un liquide en contact avec de la vapeur, il n'y a généralement pas de changement brusque de densité, mais une transition plus ou moins continue d'une densité élevée à une densité faible. L'interface consiste en une matière en vrac à évaporer ou en une matière de condensation de la phase gazeuse.

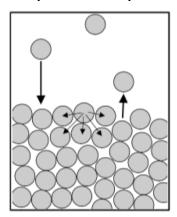




Une interphase est un composé chimique composé des deux phases environnantes.

9.1.7. Différents scénarios de surface et d'interface

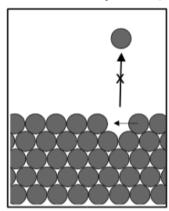
liquide / vapeur



liquide très mobile et désordonné

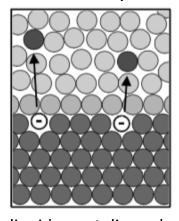
évaporation et recondensation constantes en surface

solide / vapeur (vide)



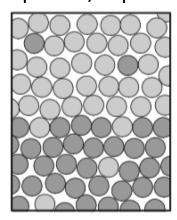
solide hautement immobile Solides cristallins hautement ordonnés / structuré généralement pas d'évaporation d'atomes de surface et de molécules, seulement diffusion latérale (dépend de T)

solide / liquide



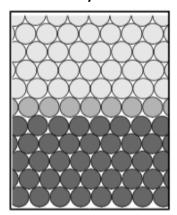
liquide peut dissoudre les atomes de surface et peut produire des charges à la surface

liquide1 / liquide2



les deux phases très mobiles la forme de l'interface est contrôlé par la tension superficielle

solide1 / solide2



Si les deux matériaux réagissent ensemble, un nouveau composé sera formé dans la région de contact

9.1.8. Frittage



Video displays

Au nanoparticle sintering

at 1k x 1k resolution as images were binned x4. During in-situ recordings, individual images at obtained at full resolution (4k x 4k) so you can create high resolution movies from the entire sample area or just a subregion. This is the first of three videos on Au nanoparticle sintering that show how sample details are maintained in smaller regions of interest

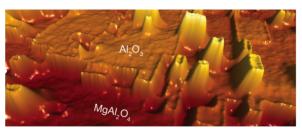
(https://www.youtube.com/watch?v=eoATFO7lszU and https://youtu.be/H5ohOFtJ3Yg and https://youtu.be/aQF3Z1d2oNQ).

Sample: Au nanoparticles; beam energy: 300 kV; original image size: 4k x 4k; frame rate: 25 fps; skips 5 frames; binning x4

Video courtesy JEOL Japan and Gatan, Inc., US

OneView IS movie shows full field of view $(35 \times 35 \text{ nm}^2)$.

9.2. La structure d'une surface



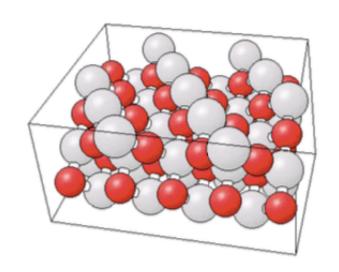
La morphologie d'une surface est une propriété macroscopique ou d'ensemble qui définit sa forme.

exemple: film d'alumine développé sur un substrat d'aluminate de magnésium

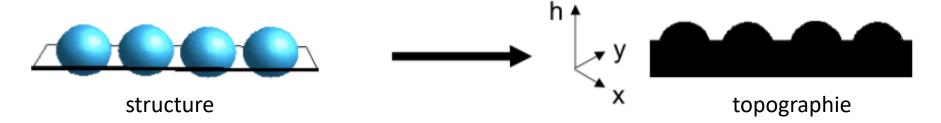
La structure d'une surface est donnée par la composition atomique et moléculaire et la disposition des atomes dans l'espace.

Géométrie de AgBr (111) - (2x1) →

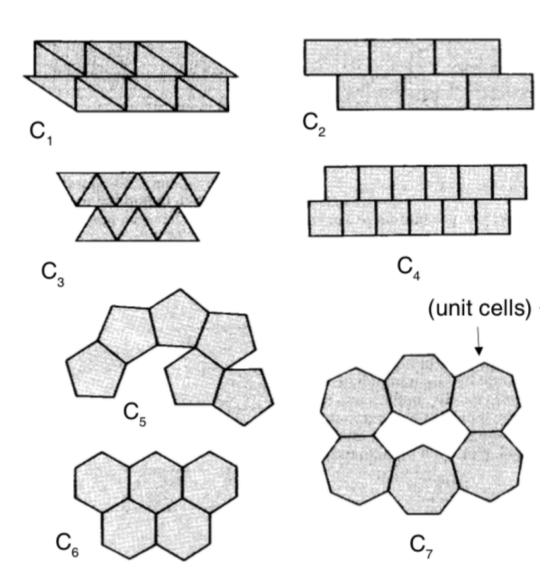
avec la permission de PR Watson, MA Van Hove et K. Hermann: http: //www.fhibernlin.mpg.de/th/personal/hermann/img_title.cgi?var1=./SSDfig151.gif&var2 = AgBr (111) - (2x1)



La topographie d'une surface est son profil déterminé par "vallée", "plans" et "collines". h



9.2.1. Structure model de la surface

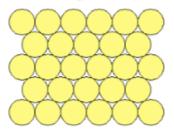


tassement dense possible uniquement avec Cn: n = 1,2,3,4,6

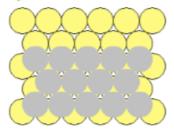
9.2.2. Les trois structures de base sont fcc, hcp et bcc

Les trois structures cristallines de base les plus courantes sont fcc, hcp et bcc

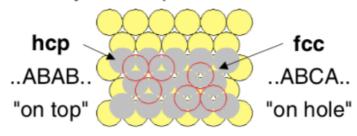
first layer: hexagonally close-packed



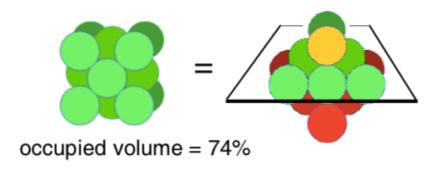
second layer: sits in hollow sites



third layer: two possible locations



fcc: face–centred cubic, coordination number CN = 12



hcp: hexagonal close-packed, CN = 12



occupied volume = 74%

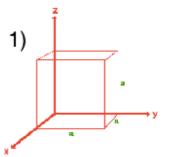
bcc: body-centred cubic, CN = 8

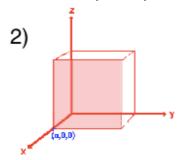


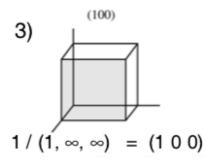
occupied volume = 68%

9.2.3. Faces en cristal et Indices Miller

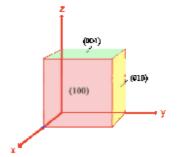
Les faces des cristaux idéaux (une coupe à travers le réseau) sont étroitement liés au cristal idéal surfaces. Pour spécifier un plan particulier, on utilise généralement les **indices de Miller**.







remarque: les réseaux hexagonaux et trigonaux utilisent 4 indices de Miller par convention (redondant)!



Procédure:

1) Identifiez les notions des faces dans x-, y- et z-axes.

1xa,∞xb, ∞xc

(exemple: réseau cubique a = b = c, α = β = γ = 90 °)

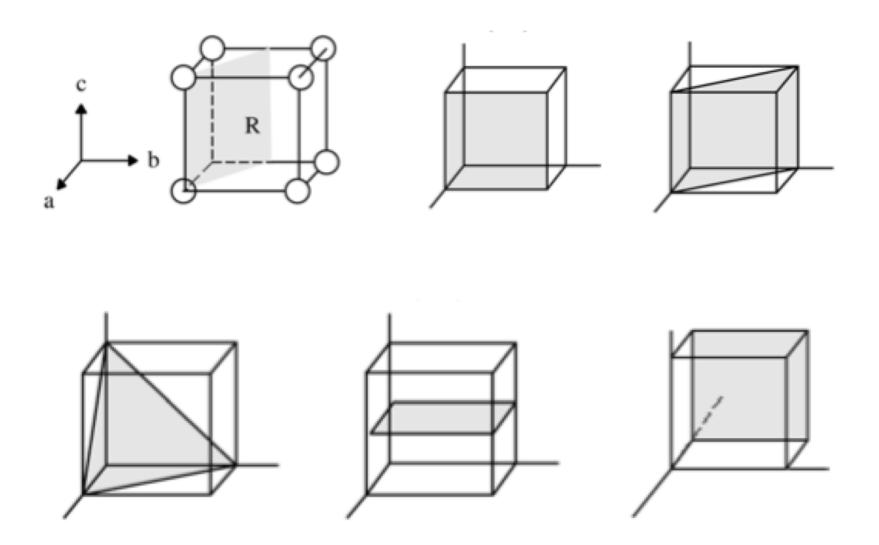
2) Spécifiez les intersections en coordonnées fractionnaires des paramètres de cellule d'unité a, b, c.

$$\Rightarrow$$
 (1xa)/a, (∞ xb)/b, (∞ xc)/c \rightarrow 1, ∞ , ∞

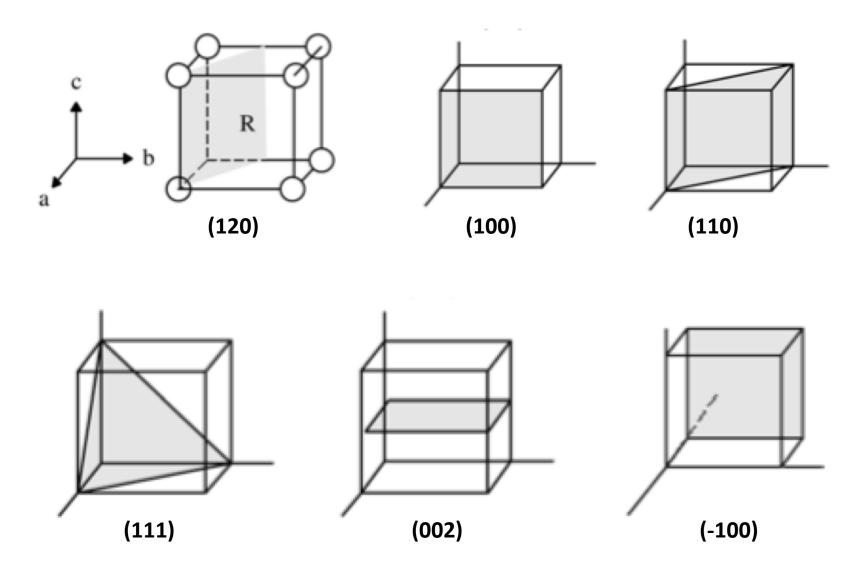
3) Prendre la réciproque des intersections fractionnaires, fractions claires. $1/(1, \infty, \infty) = (100)$ valeurs de valeurs négatives hkl

pour le réseau cubique: (100), (010), (001) sont identiques

Exercice: Déterminer les Indices Miller

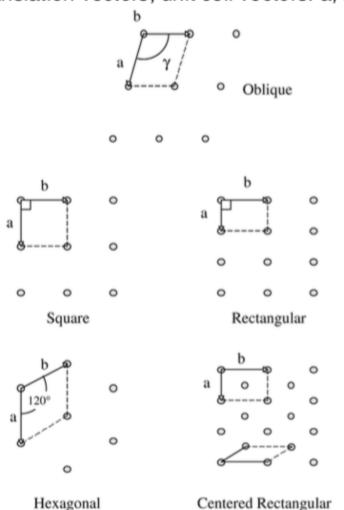


Solution: Déterminer les Indices Miller

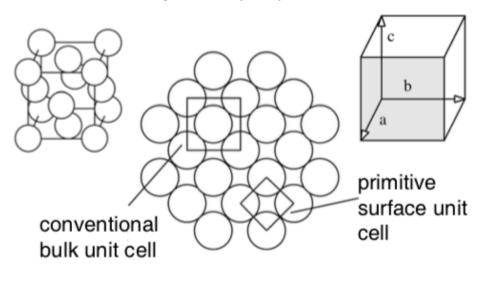


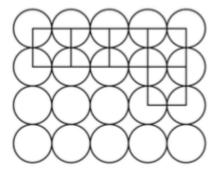
9.2. 4. Réseau 2D simple

translation vectors, unit cell vectors: a, b



example: Au (100) surface

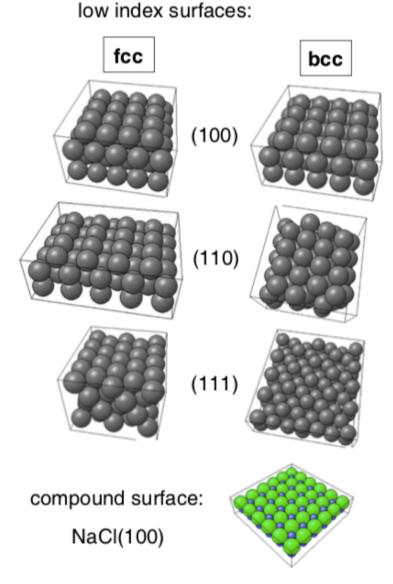




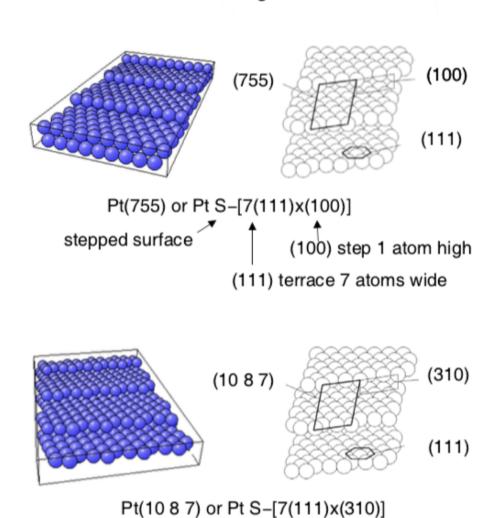
primitive cell obeys translation symmetry

see also "Wallpaper Groups: lattices": http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/wallpaper/lattices.html

9.2.5. Surfaces de cristal idéales



high index surfaces:

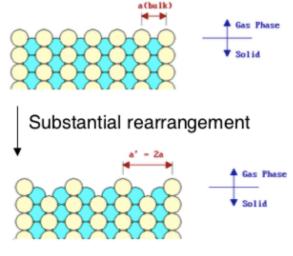


(steps with kinks)

9.2.6. Surfaces cristallines - Reconstruction et super-réseaux

Relaxation: Vacuum \ Gas Phase Description: Bulk Solid distance change < 10% Vacuum \ Gas Phase Description: Bulk Solid Bulk Solid

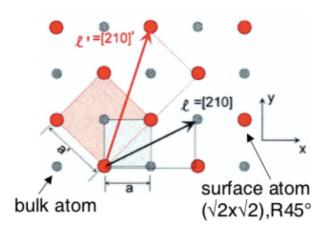
Reconstruction:



ightarrow satisfying dangling bond

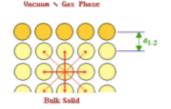
Superlattices:

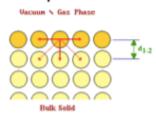
unit surface cell different from the bulk-projected substrate

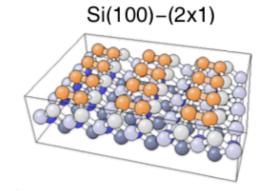


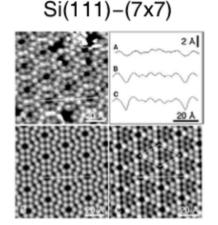
driving force:

unbalanced forces compared to bulk

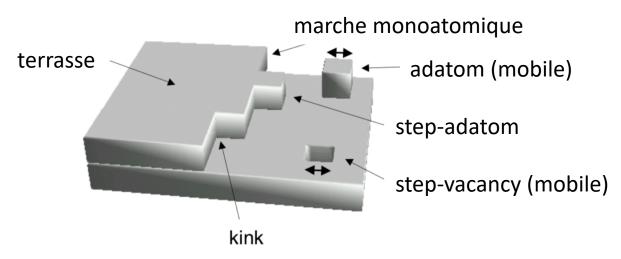








9.2.7. Défauts de surface et structures



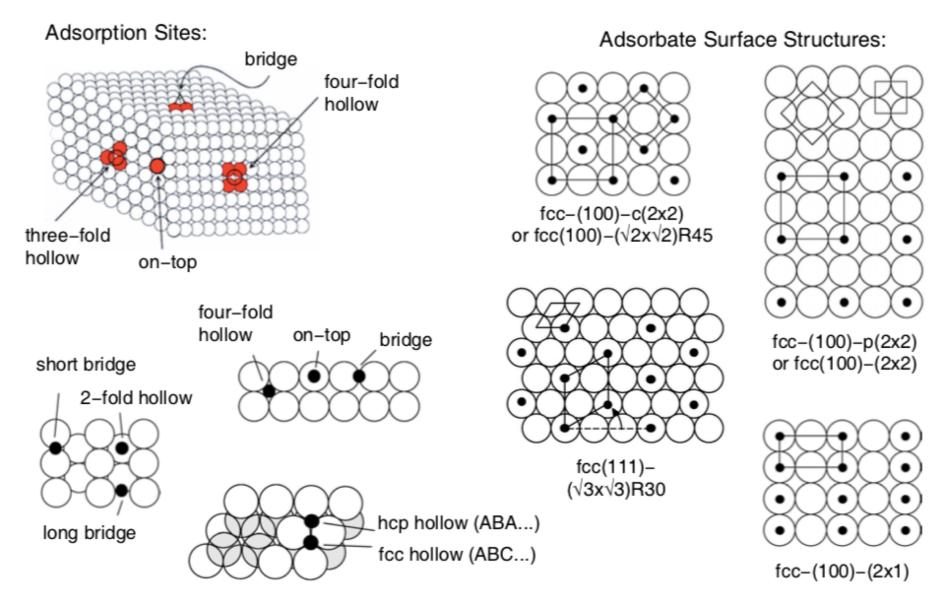
Les défauts de surface sont importants pour la croissance des cristaux:

- pièges pour les atomes / molécules nouvellement adsorbés
- la restructuration des surfaces se produit d'abord aux défauts

Les atomes de kink-, step- et de terrasse- ont de grandes concentrations d'équilibre sur des surfaces réelles (difficile d'obtenir une surface parfaite ...)

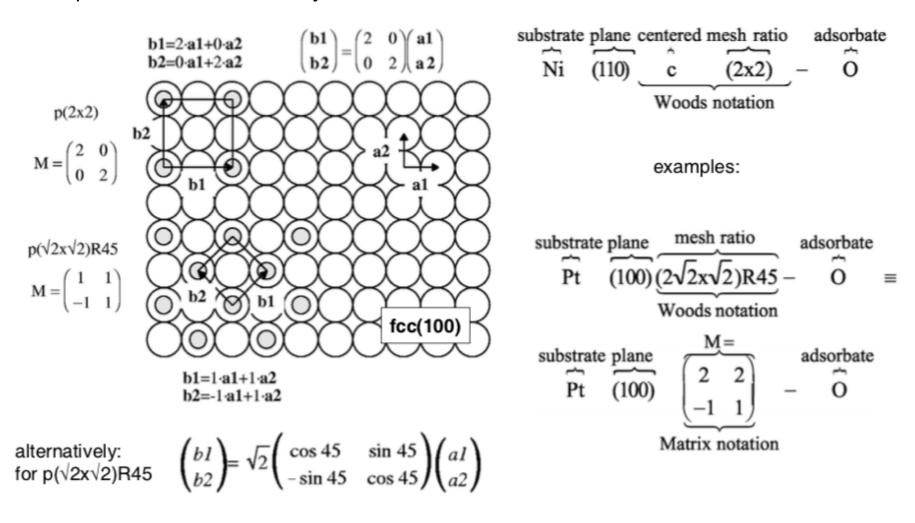
Les adatomes isolés et les lacunes sont importants pour le transport atomistique (restructuration), mais la concentration à l'équilibre est faible (<1% de monocouche même à T_{fusion})

9.2.8. Sites de surface et les adsorbant



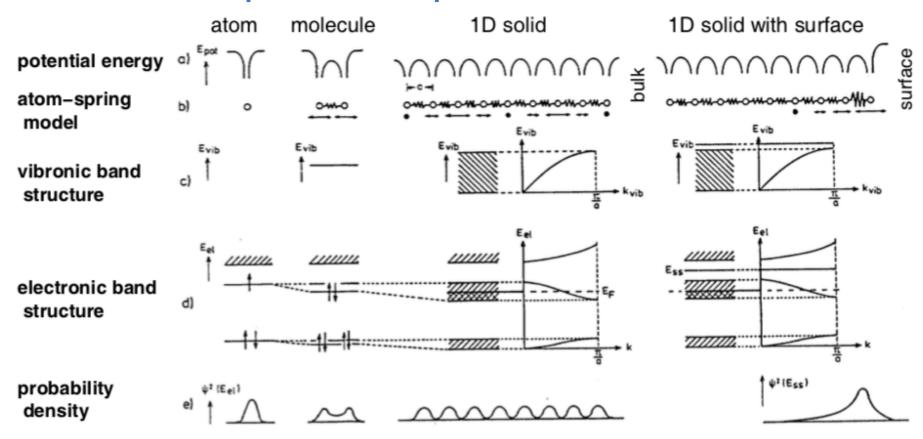
9.2.9. Notation de Wood et Notation de matrice

Description de la couche ordonnée (atomes et molécules adsorbés) en termes de relation avec le plan cristallin idéal sous-jacent.



9.3. Propriétés des surfaces

9.3.1. Caractéristiques électroniques et vibratoires des surfaces



phonon wave vector: $k_{vib} = 2\pi / \lambda_{vib}$ with λ_{vib} : phonon wave length, a: lattice constant electron wave vector: $k = 2\pi / \lambda$ with λ : electron wave length, a: lattice constant

 E_{pot} : potential energy, E_{vib} : vibonic energy, E_{el} : electronic energy , E_{ss} : energy of the surface state

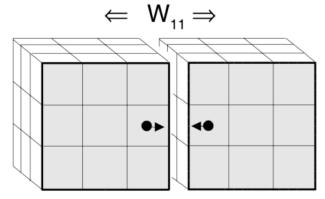
9.3.2. Énergie de surface W₁₁

Le travail W_{11} visant à réunir deux surfaces idéales identiques dans le vide est lié à l'énergie de surface 1 du matériau:

 $W_{11} = -2 \cdot \gamma_1$ (normalisé à la surface de l'unité!) $\gamma_1 = dW/dA$

 W_{11} correspond au travail de cohésion dans un cas idéal et est normalisé à la zone des surfaces. Ce **travail** devrait être identique à la **séparation** d'un corps en deux moitiés. En réalité, le processus de séparation est irréversible (en raison de la dissipation d'énergie), le travail de séparation / cohésion est donc supérieur à l'énergie de surface.

Énergie de surface élevée ⇒ forte cohésion ⇒ point d'ébullition élevé ...



Iron 1/6 nouvelle surface par élément de structure dans le plan de clivage

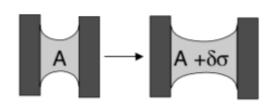
matériau de substrat	énergie de surface (mJ/m²)
mica	4500
l'Or	~ 1000
PTFE	19
OTE (surface octadécane)	28

Les surfaces à haute énergie tendent à réduire l'énergie par **adsorption** de contaminants de l'environnement!

9.3.3. Tension surface γ

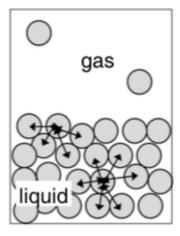
La tension surface γ est définie par le travail infinitésimal dw requis pour augmenter la surface par une zone infinitésimale $\delta\sigma$:

$$dw = \gamma \delta \sigma$$



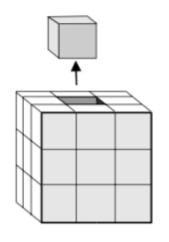
- → le travail doit être appliqué pour augmenter surface, puisque les liquides ont tendance à minimiser leur surface (gouttelettes sphériques)
- → Balance équilibre des forces

$$\gamma = dw/d\sigma$$



- → La tension surface des liquides correspond à l'énergie de surface des solides
- → Tension de surface / énergie de surface en corrélation avec l'enthalpie d'évaporation

material	γ (mN m -1)	ΔH_{vap} (kJ mol ⁻¹)
C ₆ H ₆	28.8	30.8
MeOH	26.6	35.3
H ₂ O	72.7	40.7
Hg	472	59.3



~ 5/6 nouvelle surface par élément de structure

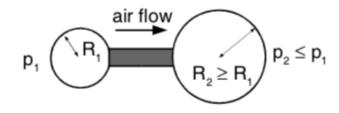
9.3.4. Mesure de la tension de surface

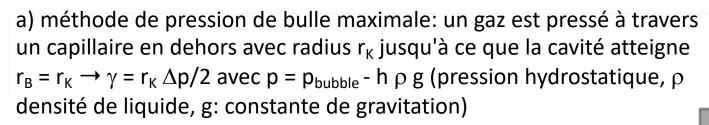
L'équation Young-Laplace décrit la différence de pression p entre l'intérieur et l'extérieur d'un objet incurvé (bulle, gouttelette, cavité) de rayon r_a et r_b ($r_a \perp r_b$, en géométrie symétrique $r = r_a = r_b$) par rapport à la tension surface γ :

$$\Delta p = \gamma \left(\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b}\right)$$

en termes de pression interne:

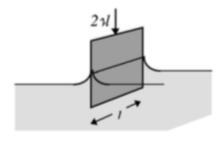
$$p_{in} = p_{out} + 2\gamma / r$$





b) méthode du poids de la goutte: taille maximale de la goutte avant relâchez m_{drop} $g = 2\pi r_k \gamma$ avec le poids de la goutte m_{drop}

$$\Rightarrow$$
 4/3 π r_{drop} ρ_{liq} g = 2π r_k γ



c) Méthode des plaques de Wilhelmi: force F (en plus de la force de gravitation) sur une plaque de largeur l partiellement immergée dans un liquide $F = 2l\gamma$

9.4. Physisorption

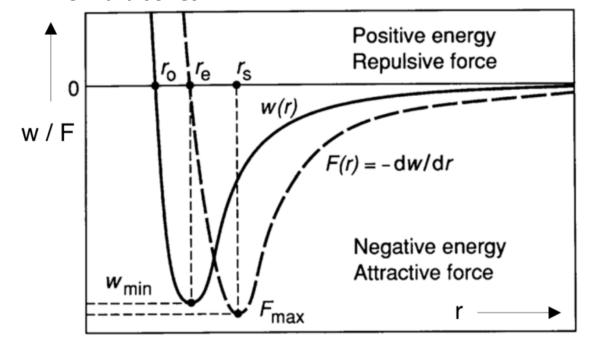
- van der Waals: écart de comportement des gaz réels par rapport à la loi des gaz parfaits $(p \cdot V = n \cdot R \cdot T)$: \checkmark volume exclu d'atomes

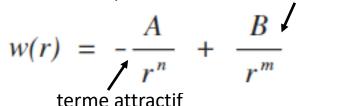
 $\left(p + \frac{a}{\sqrt{V^2}}\right)(V - b) = R \cdot T$

molécules attrayants forces intermoléculaires (forces de van der Waals)

- Mie: "potentiel de paire" d'interaction générale pour décrire les interactions complexes intermoléculaires:

- Lennard-Jones:





terme répulsif

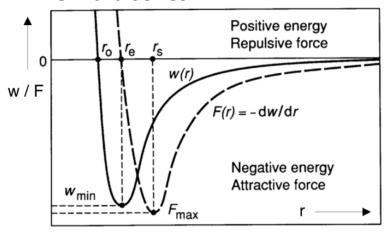
interaction de van der Waals attrayante à long terme

$$w(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

"sphère dure" à très courte portée

Exercice: Calculer F(r) = -dw/dr et determiner A et B

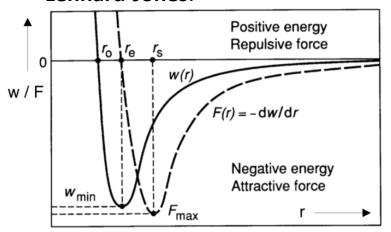
- Lennard-Jones:



$$w(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

Exercice: Calculer F(r) = -dw/dr et determiner A et B

- Lennard-Jones:



$$w(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

$$F(r) = -\frac{dw(r)}{dr} = 6 \cdot \frac{A}{r^7} - 12 \cdot \frac{B}{r^{13}}$$

$$F(r_e) \; = \; 0 \; \rightarrow \; r_e^6 \; = \; \frac{2 \cdot B}{A} \; \rightarrow \; A \; = \; \frac{2 \cdot B}{r_e^6}$$

$$w(r_0) = 0 \rightarrow r_0^6 = \frac{B}{A}$$

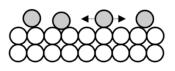
$$W_{min} = -\frac{A}{r_e^6} + \frac{B}{r_e^{12}} \rightarrow B = -r_e^{12} \cdot W_{min} \rightarrow A = -2 \cdot r_e^6 \cdot W_{min}$$

9.4.1. Adsorption à la surface

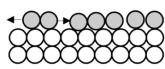
L'adsorption est l'accumulation de particules (adsorbat) sur une surface (adsorbant ou substrat). Le processus inverse s'appelle la désorption.

couverture de surface fractionnaire: $\theta = \frac{\text{Nombre de sites d'adsorption occupés}}{\text{Nombre de sites d'adsorption total}}$

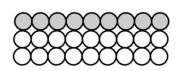
faible couverture: gaz 2D (pas d'attraction entre les atomes / molécules d'adsorbat, forte mobilité, désordonné)



couverture moyenne: liquide 2D (attraction entre les atomes / molécules d'adsorbat -> condensation, réduit mobilité, désordonné)



couverture élevée: solide 2D (forte attraction entre les atomes / molécules d'adsorbat -> cristallisation, aucune mobilité, fortement ordonné)



Sites d'adsorption: au-dessus des atomes, entre les atomes (2, 3, 4 fois), les arêtes, les marches, les nœuds ...

- → Le superlattice adsorbé est décrit par la notation de Wood
- → Reconstruction de la surface du substrat parfois induite par l'adsorbat [Ni(100) c(2x2)-CO]

Ref.: Prof. Dr. Ulrich Jonas, Macromolecular Chemistry, Department Chemistry - Biology, University of Siegen

9.4.2. Physisorption et Chemisorption

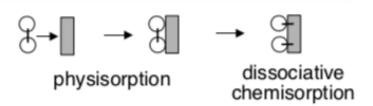
Physisorption (adsorption physique): attraction de longue portée et faible de van der Waals entre adsorbat et substrat (5 kJ·mol⁻¹ < $\Delta H_{physisorption}$ < 50 kJ·mol⁻¹)

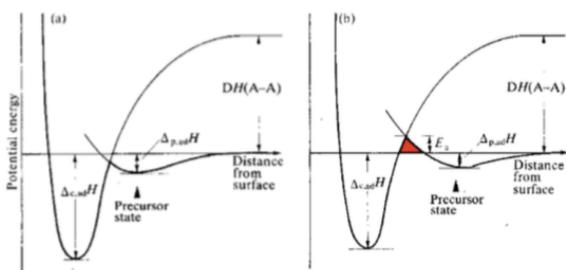
- pas de barrière d'activation, rapide, réversible, insensible à la symétrie de surface, formation multicouche possible, $T_{\text{surface}} < T_{\text{condensation}}$

Chimisorption: liaison étroite et forte entre l'adsorbat et le substrat (50 kJ·mol⁻¹ < $\Delta H_{chemisorption}$ < 250 kJ·mol⁻¹)

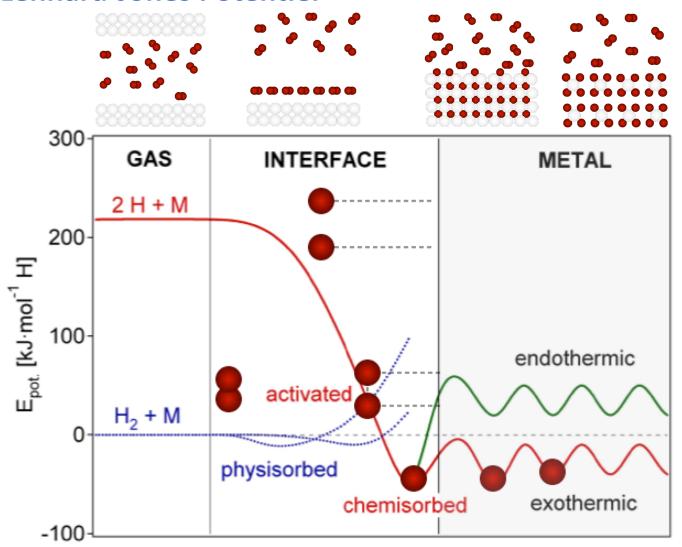
- barrière d'activation possible (b), cinétique d'adsorption variable, liaison covalente / ionique / métallique, souvent irréversible, symétrie de surface spécifique, limitée à une monocouche, large plage de T_{surface}

adsorption dissociative: lors de la chimisorption, les molécules peuvent se dissocier en atomes / fragments individuels





9.4.5. Lennard-Jones Potentiel





John Edward Lennard-Jones 1894 - 1954

← d

Ref.: J. E. Lennard-Jones, "Processes of adsorption and diffusion on solid surfaces", Transactions of the Faraday Society 28 (1932), pp. 333 - 359

9.4.6. Isotherme d'adsorption de Langmuir

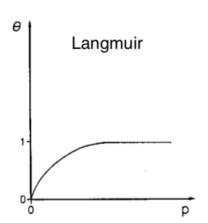
Isotherme de Henry: la couverture de surface θ dépend linéairement de la pression p (cas particulier de Langmuir pour θ = 0) $\theta = k_H \cdot p$

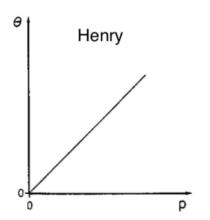
Isotherme de Langmuir: hypothèse de a) couverture maximale de la monocouche (θ = 1); b) pas d'interaction entre les atomes / molécules d'adsorbat; c) énergie de liaison indépendante de la couverture; e) équilibre thermodynamique du taux d'adsorption (k_a) et de désorption (k_d), ($d\theta/dt$) égal

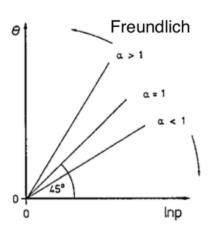
$$\text{adsorption: } \frac{d\theta}{dt} = k_a \cdot p \cdot N \cdot (1 - \theta) \quad \text{désorption: } \frac{d\theta}{dt} = k_d \cdot N \cdot \theta \quad \longrightarrow \quad \theta = \frac{K \cdot p}{(1 + K \cdot p)}, \quad K = \frac{k_a}{k_d}$$

Isotherme de Freundlich: modifications de l'enthalpie d'adsorption de manière logarithmique $\theta = K \cdot p^{\alpha}$

Isotherme de Tempkin: modifications de l'enthalpie de l'adsorption $\theta = c_1 \cdot \ln(c_2 \cdot p)$







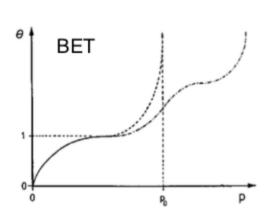
9.4.7. BET et autres isothermes d'adsorption

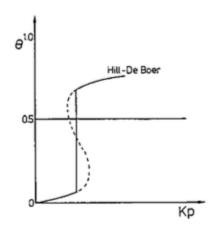
BET (Stepen Brunauer, Paul Emmett, Edward Teller): hypothèse selon laquelle d'autres couches d'adsorbat physisorbé peuvent se former sur la première couche

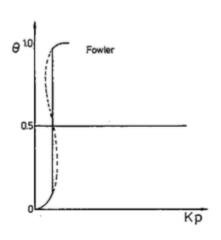
- différentes constantes de vitesse d'adsorption et de désorption pour la première couche (k_a, k_d) et les couches physisorbées suivantes $(k_{a'}, k_{d'})$
- condensation à p_0 (pression de vapeur dans la masse), à forte couverture $\theta >> 1$ système similaire à une interface dans la masse / vapeur
- applicable aux gaz non réactifs sur les surfaces polaires

Hill-de Boer: gaz 2D mobile, dimensions moléculaires et interactions vdW entre particules adsorbées considérées

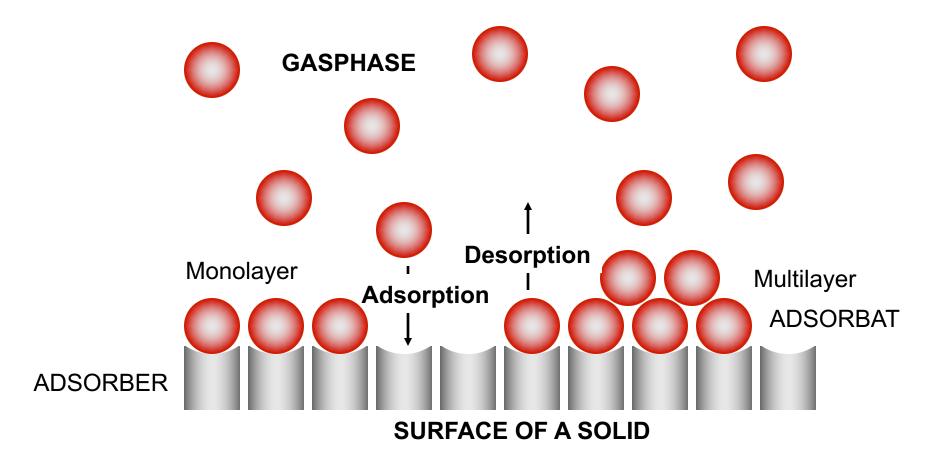
Fowler: adsorption localisée avec interaction des particules adsorbées



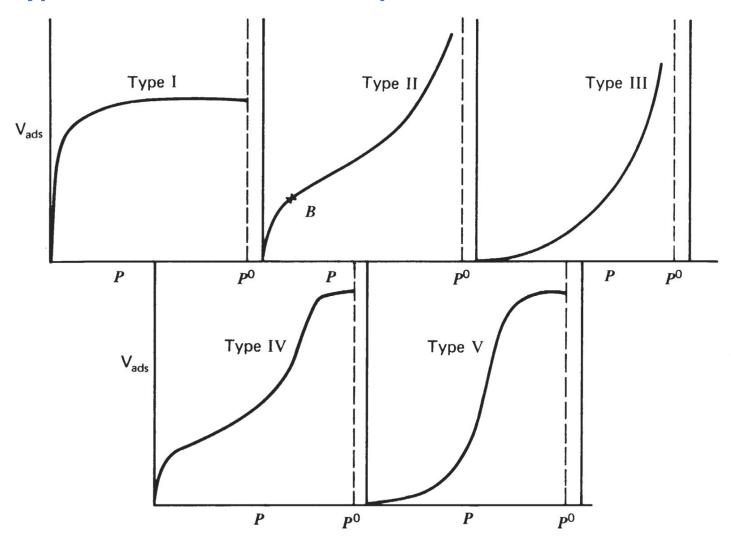




9.4.8. Model d'adsorption BET

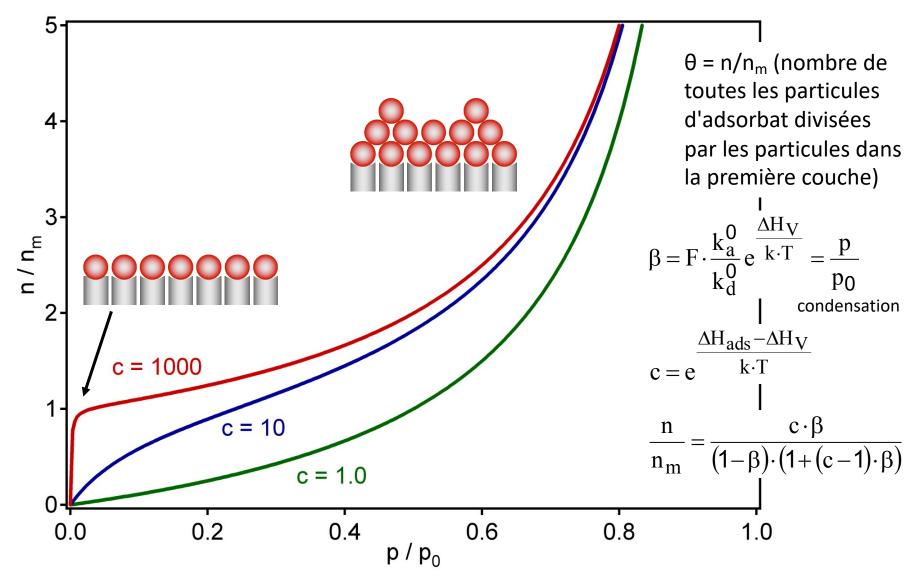


9.4.9. Type de l'isotherme d'adsorption BET



Ref.: Brunauer S, Emmett P H & Teller E., "Adsorption of gases in multimolecular layers." Journal of the American Chemical Society 60 (1938), pp. 309-319

9.4.10. Description de l'isotherme d'adsorption BET



9.4.11. Mesurer la surface spécifique au moyen de BET

Exercices: Calculer la surface d'une monocouche des gaz suivants: N2, H2, CO2, Ar

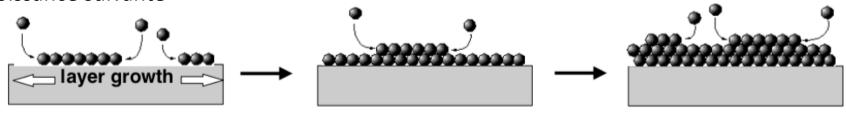
Gas	ρ [g/cm³]	VdWaals b [cm ³ ·mol ⁻¹]	M [g·mol ⁻¹]	A [m²·mol ⁻¹]	d [Å]	d _{vdW} [Å]
H_2	0.082	26.61	2	71022	3.43	3.53
He	0.147	23.8	4	76397	3.56	3.40
N_2	0.808	38.7	28	89759	3.86	4.01
CO_2	1.562	42.67	44	78180	3.60	4.14
Ar	1.43	32.01	40	77747	3.59	3.76
H_2O	0.9998	30.49	18	58001	3.10	3.70

$$d = \left(\frac{V_M}{N_A}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{M}{\varrho \cdot N_A}\right)^{\frac{1}{3}} \qquad d = \left(\frac{b}{N_A}\right)^{\frac{1}{3}}$$

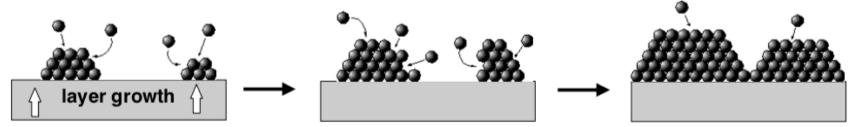
$$A = \frac{V_M}{N_A} \left(\frac{M}{\varrho \cdot N_A}\right)^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{M}{\varrho}\right)^{\frac{2}{3}} \left(\frac{1}{N_A}\right)^{-\frac{1}{3}}$$

9.5. Chimisorption

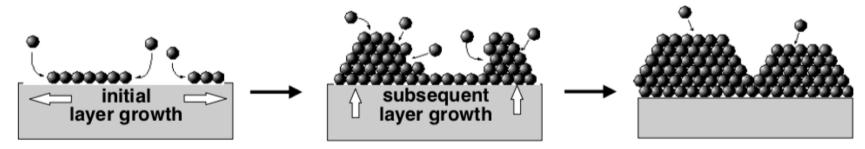
Frank-van der Merwe: croissance de la couche 2D, achèvement de la couche avant la croissance suivante



Volmer-Weber: croissance d'îles en 3D à partir de sites de nucléation

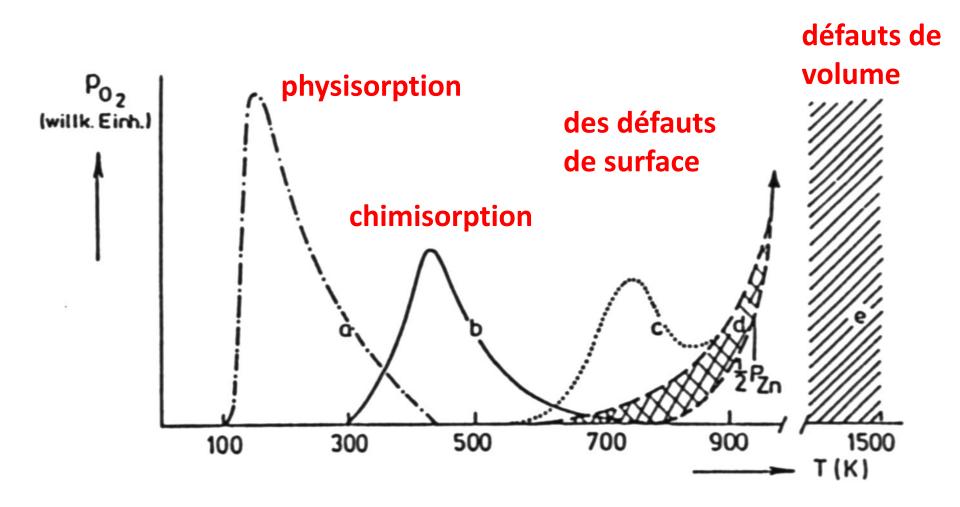


Stranski-Krastanov: croissance initiale de la couche 2D, formation ultérieure d'îlots 3D

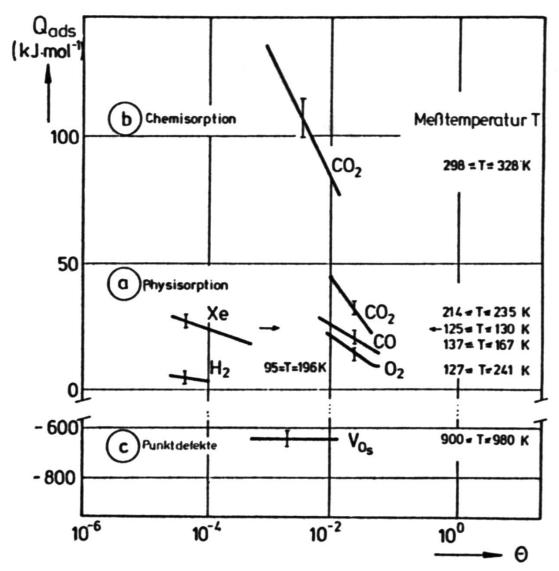


Croissance en colonne: à très faible mobilité atome / molécule, les structures en colonne 3D hautement défectueuses se développeront (amorphe, poreux)

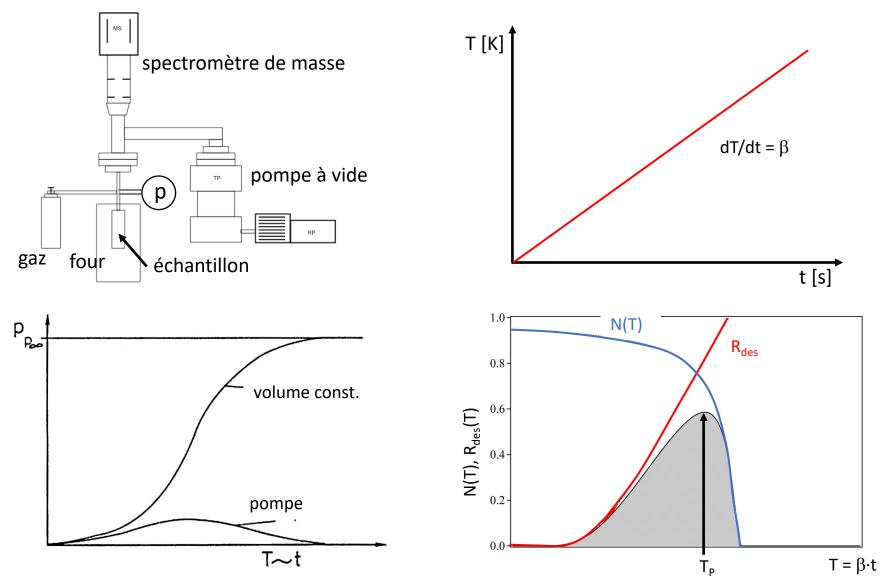
9.5.1. Désorption thermique



9.5.2. Chaleur adsorption par rapport à la couverture



9.5.3. Spectroscopie de désorption thermique



9.5.4. Determiner l'energy d'activation

$$ln(T_P^2/\beta)$$

$$R_{des} = -\frac{dN}{dt} = N \cdot k_0 \cdot e^{-\frac{E_A^d}{R \cdot T}}$$

 $\frac{dT}{dt}$ = β taux de chauffage

$$-\frac{dN}{dT} = N \cdot \frac{k_0}{\beta} \cdot e^{-\frac{E_A^d}{R \cdot T}}$$

$$ln\left(\frac{E_A^d}{R}\right) - ln(k_0)$$

$$-\frac{E_A^d}{R}$$

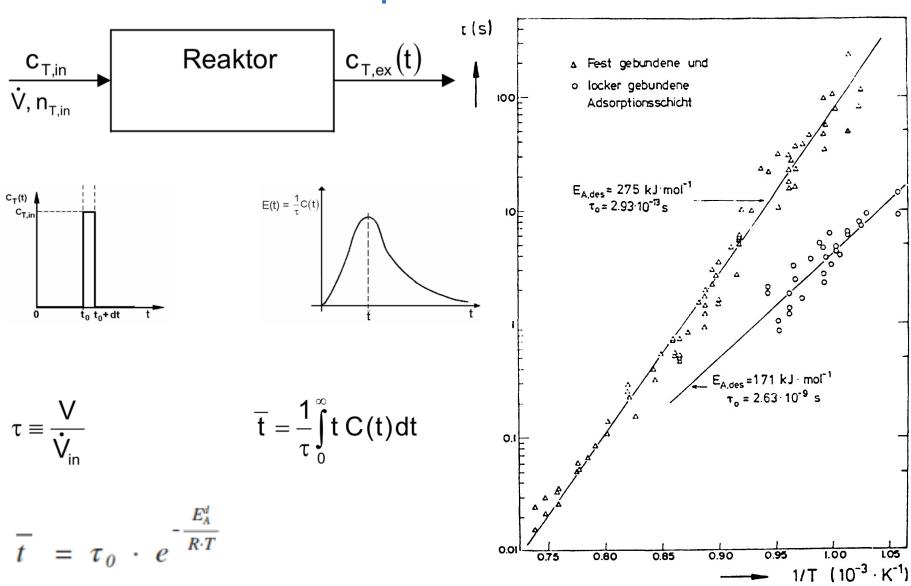
$$1/\mathsf{T}_\mathsf{P}$$

$$\frac{d}{dT}\left(\frac{dN}{dT}\right) = \frac{k_0}{\beta} \cdot \left\{ \frac{dN}{dT} \cdot e^{-\frac{E_A^d}{R \cdot T}} - N(T) \cdot \frac{E_A^d}{R \cdot T^2} \cdot e^{-\frac{E_A^d}{R \cdot T}} \right\}$$

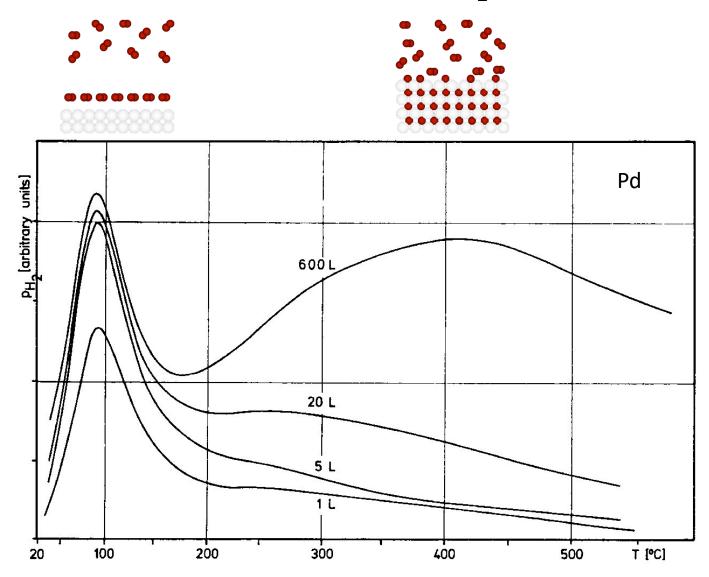
$$\frac{E_A^d}{R} = \frac{k_0}{\beta} \cdot T_p^2 \cdot e^{-\frac{E_A^d}{R \cdot T}}$$
 maximum dN/dT vs. T

$$ln\left(\frac{T_P^2}{\beta}\right) = ln\left(\frac{E_A^d}{R}\right) - ln(k_0) + \frac{E_A^d}{R \cdot T_p}$$

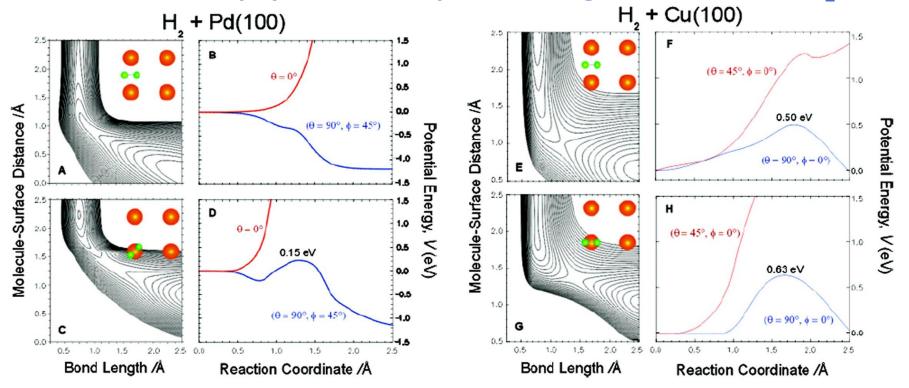
9.5.5. Détermination du temps de résidence



Example: Désorption thermique: H₂ physisorbé et chimiesorbé



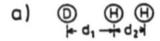
9.5.6. Surfaces équipotentielles pour l'énergie d'interaction H₂ et Cu

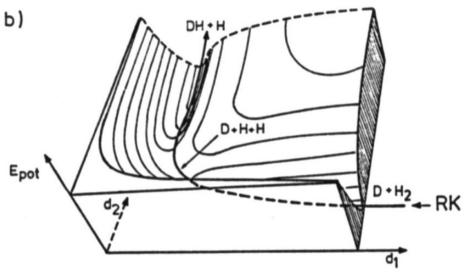


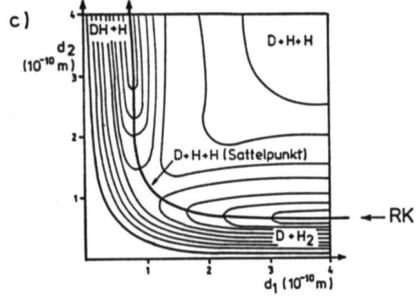
Zones potentielles (les lignes potentielles sont indiquées à une distance de 0,1 eV) pour H_2 + Pd (100) (A-D) et H_2 + Cu (100) (E-H). Coupes bidimensionnelles des surfaces potentielles pour une molécule H_2 parallèle à la surface (θ = 90 °), pour un site pont (A pour H2 sur Pd et E pour H2 sur Cu) et un carré d'atome de métal (C pour H_2 sur Pd et G pour H_2 sur Cu) et pour une molécule H_2 inclinée à la surface (θ = 45 °). φ est l'angle d'azimut du poids moléculaire.

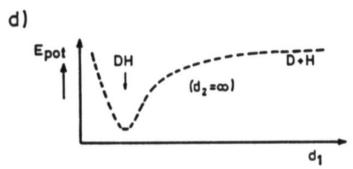
Ref.: G. J. Kroes, A. Gross, E. J. Baerends, M. Scheffler, and D. A. McCormack, "Quantum Theorie of Dissociative Chemisorption on Metal Surfaces", Acc. Chem. Res. 35 (2002), pp. 193-200.

9.5.7. Échange isotopique H, D









Surfaces d'énergie et coordonnée de réaction RK pour la réaction $H_2 + D \rightarrow DH + H$. où d1 est la distance de D à H, d_2 est la distance de H à H. Les atomes sont disposés linéairement à chaque instant.

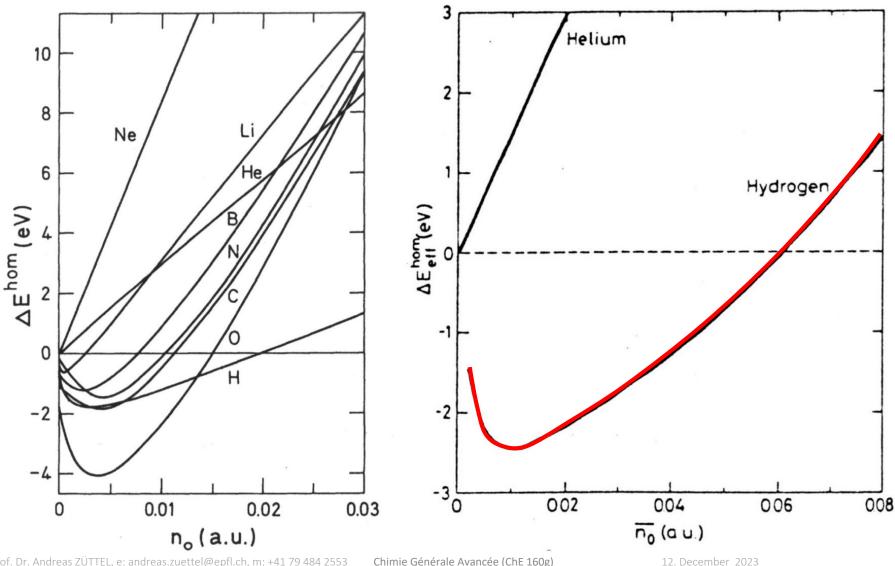
- a) Définition des distances d₁ et d₂,
- b) Représentation en perspective de l'hyperface énergétique,
- c) Diagramme linéaire en couches,
- d) Diagramme de potentiel des molécules DH pour $d_2 = \infty$

9.5.8. Calcul DFT de l'énergie de H

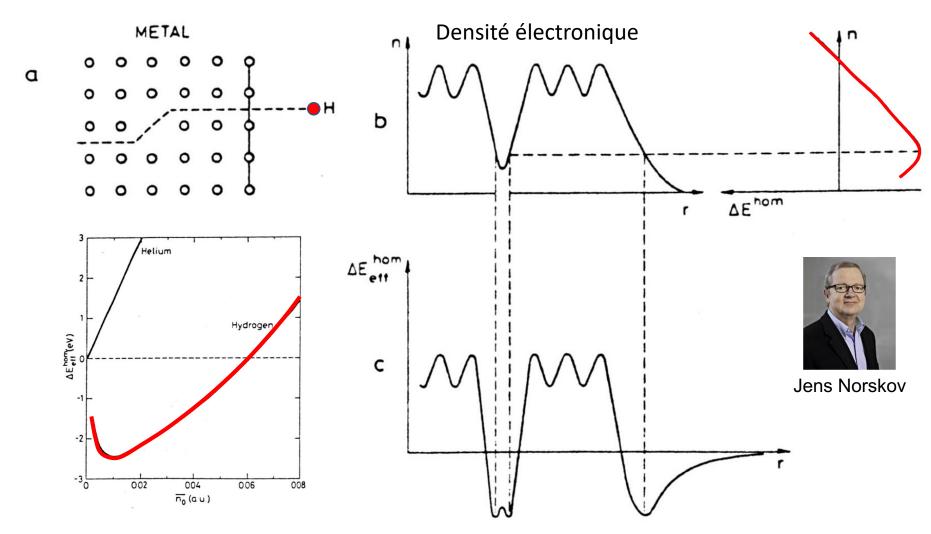
DFT: density functional theory



densité électronique



9.5.9. Energie d'un atome de H dans un métal (calcule DFT)



Ref.: P. Nordlander, J. K. Norskov, and F. Besenbacher, J. Phys. F. Metal Phys. 16:9 (1986), pp. 1161-1171, J.K. Norskov and F. Besenbacher, J. of the Less-Common Metals 130 (1987), pp. 475-490